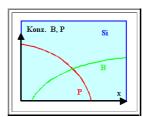
Übung 9.3-1

Schnelle Fragen zu

9.3 Raumladungszonen und Übergänge

Schnelle Fragen zu 9.3.1: Grundsätzliches

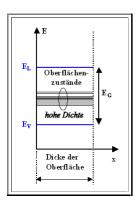
Das Bild unten zeigt Konzentrationen von Bor (B) und Phosphor (P)i n einem Stück Si. Ist ein pn-Übergang vorhanden? Falls, ja, warum und wo? Welche Seite wäre ggf. n-Si, welche p-Si?



- Wie würde man solche Konzentrationsprofile machen?
- Was ist ein Schottky Kontakt (qualitative I-U-Kennlinie angeben). In was unterscheidet er sich von einem Ohmschen Kontakt (qualitative I-U-Kennlinie angeben)? Welche Materialien sind in beiden Fällen im Kontakt?
- Nenne (im Zweifel "gefühlt") einige andere Kontakte mit nicht-linearer Kennlinie (d. h. keine Ohmschen Kontakte).
- Wie macht man elektronisch interessante Kontakte ganz sicher nicht und warum ? Wie macht man es, oder könnte es prinzipiell machen?
- Warum sind Diffusion und die Fickschen Diffusionsgesetze die Grundage aller Halbleitertechnologie?

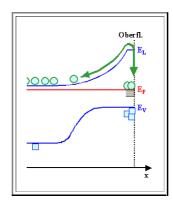
Schnelle Fragen zu 9.3.2: Oberflächenzustände und Bandverbiegung

- Wie dick ist eine reale Oberfläche mindestens? Wieviele Atome pro cm² finden ungefähr Platz auf der Oberfläche für einen Kristall mit Gitterkonstante a?
- Warum gibt es für Elektronen an der Oberfläche Zustände in der Energielücke; oder generell andere Zustände als für Elektronen im Volumen?



- Wie groß ist in etwa die Zahl der Zustände für die gezeigten Oberflächenzustände in cm⁻² und cm⁻³ (endliche Dicke beachten). Nebenbei: Wie kommt man von der Zustandsdichte zur Gesamtzahl?
- Gegeben sei eine große Zahl von Oberflächenzuständen wie im nebenstehenden Bild angedeutet. Wo kann die Fermienergie nur liegen? Hinweis: Überwiegend nicht besetzt Zustände liegen immer oberhalb der Fermienergie.
- Wie sieht das Banddiagramm vermutlich an einer Korngrenze in polykristallinen Halbleitern aus?
- Was geschieht, wenn sich ein n-Halbleiter mit seiner Oberfläche "in Kontakt" setzt? Hinweis: Man versetze sich in die Lage der Elektronen im Leitungsband, die auf der Suche nach Plätzen mit niedrigerer Energie sind.
- Was geschieht, wenn sich ein p-Halbleiter mit seiner Oberfläche "in Kontakt" setzt? Hinweis: Man versetze sich in die Lage der Löcher im Valenzband, die auf der Suche nach Plätzen mit höherer Energie sind.
- 🔵 Konstruiere für beide obigen Fälle das Banddiagramm; folge und erläutere dabie das "drei-Stufen-Rezept".
- Was für Partialströme fließen über die Raumladungszone? Wie groß sind sie? Was sind die treibenden Kräfte für diesen Stromfluss?
- Wieso ist die Fermienergie im Gleichgewicht überall gleich groß?
- Rutschen die Bänder an Stellen negativer Ladung "rauf" oder "runter"? Wie kann man sich das sofort klarmachen?

Das nachfolgende Bild zeigt ein Banddiagramm, bei dem die Bandverbiegung in Leitungs- und Valenzband verschieden ist - die Löcher könnten ja andere Verhältnisse haben als die Elektronen. Warum ist das Blödsinn und komplett falsch?



Schnelle Fragen zu 9.3.3: Bandverbiegung und Raumladungszone

Warum gibt es in Raumladungszonen so gut wie keine freien Ladungsträger? Nenne zwei Gründe!

1.
$$C_{RLZ} = \frac{2 \cdot \epsilon_{Si} \cdot \epsilon_{0} \cdot F}{d_{RLZ}}$$

2.
$$C_{RLZ} = \frac{e^2 \cdot (N_D \cdot F \cdot d_{RLZ})}{\Delta E_F}$$

$$d_{RLZ} = \left(\frac{2 \cdot \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot \Delta E_F}{\epsilon^2 \cdot N_P} \right)^{1/2}$$

- Wir kommt man auf die erste Gleichung zur Kapazität einer Raumladungszone? Begründe insbesondere den Faktor 2.
- Was soll man sich unter der Dielektrizitätskonstanten ∈ si eines Halbleiters vorstellen? Wie groß ist sie etwa? Welcher Polarisationsmechanismus ist beteiligt?
- Welche Definition einer Kapazität C steckt hinter der zweiten Gleichung? Was steht im Nenner und was im Zähler? Wo kommt der Ausdruck "Kontaktspannung" zum Tragen?
- Wie kommt man auf die Formel für die Weite d_{RLZ} der Raumladungszone (Herleitung).
- Wie ist die d_{RLZ}-Formel zu verändern, wenn man zusätzlich zur Kontakspannung noch eine externe Spannung U_{ex} anlegt?
- Wie groß ist in etwa das elektrische Feld E_{RLZ} in einer RLZ? Formel? Skizziere halbwegs quantitativ d_{RLZ} und E_{RLZ} über N_D.

Hinweis: Die maximale Kontaktspannung hat etwas mit der Bandlücke zu tun

- 🔵 Skizziere in einem Orstbild die Verteilung der Ladungen und das elektrische Feld im Halbleiter-Oberfläche Kontakt.
- Warum kann man die Kontaktspannung mit einem Voltmeter nicht messen?